

1.29 ÷ 1.33
мкмМощность излучения
> 1.0 мВт

LFO-14-ip

Описание:

LFO-14-ip - оптические модули, изготовленные на основе неохлаждаемого 1310 нм MQW InGaAsP/InP Фабри-Перо лазерного диода состыкованного с одномодовым оптическим волокном. Выпускаются в стандартных корпусах со встроенной коллимирующей микролинзой и фотодиодом обратной связи. Модули имеют широкий диапазон рабочих температур, высокую стабильность мощности излучения и ресурс работы более $5 \cdot 10^5$ часов.

LFO-14-ip - являются лучшими источниками излучения для цифровых (до 1,25 Гбит/сек) оптических линий связи, оптических тестеров, оптических телефонов, гибких мультиплексоров, мультиплексоров PDH, SDH-оборудования уровня STM-1 (OC-3) / STM-4 (OC-12), оптических модемов и конвертеров Fast Ethernet.

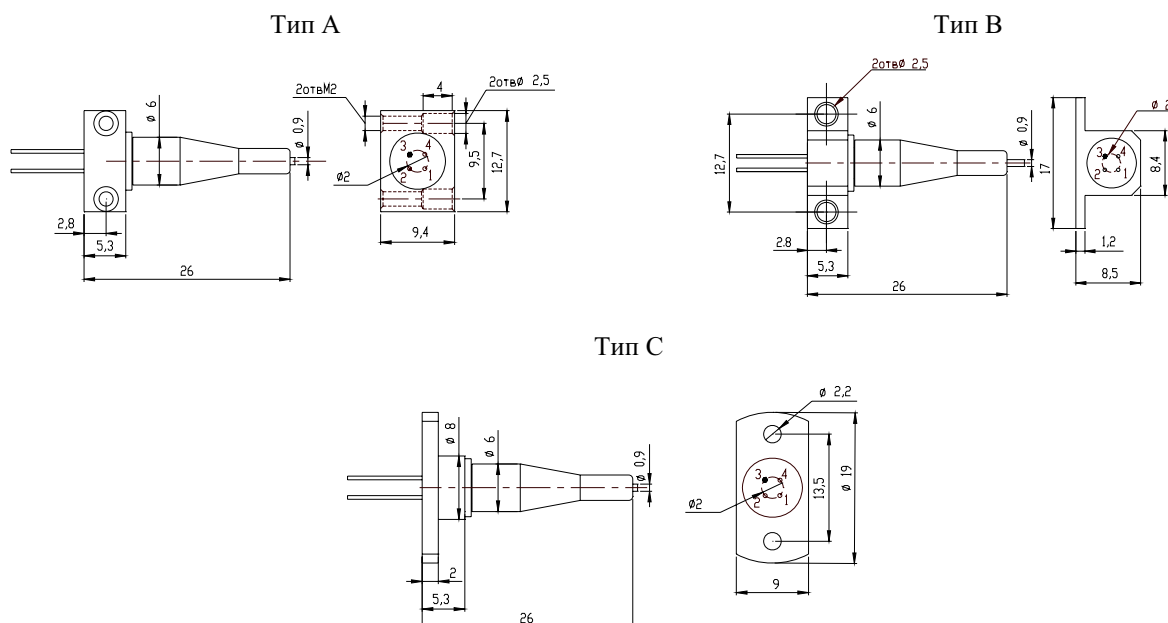
**Оптические и электрические характеристики (T=25°C):**

Характеристики	Обознач.	Усл. теста	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. измер.
Лазерный диод						
Мощность на выходе оптического волокна	P_{OP}	I_{OP}	0.8	1.0	-	мВт
Длина волны излучения	λ_{OP}	P_{OP}	1290	1310	1330	нм
Полуширина спектра излучения	$\Delta\lambda$	P_{OP}	-	1.0	2.0	нм
Время нарастания/спада оптического импульса	τ_R/τ_F	P_{OP}	-	0.3	0.5	нс
Пороговый ток	I_{TH}	CW	-	5.0	10	мА
Рабочий ток	I_F	P_{OP}	-	35	45	мА
Рабочее напряжение	U_{OP}	P_{OP}	-	1.1	1.5	В
Фотодиод обратной связи						
Управляющий фототок	I_{PD}	$U_{REV}=5.0 \text{ V}, P_{OP}$	-	500	1000	мкА
Темновой ток	I_D	$U_{REV}=5.0 \text{ V}$	-	0.01	0.1	мкА
Емкость	C_{PD}	$U_{REV}=5.0 \text{ V}, f=1 \text{ MHz}$	-	10	20	пФ
Оптическое волокно						
Диаметр жилы/оболочки	D_C/D_{CL}		-	9/125	-	мкм
Диаметр буферного покрытия	D_B		-	900	-	мкм
Длина оптического волокна	L		0.3	-	1.0	м
Условия эксплуатации						
Диапазон рабочих температур	T_{OP}		-40	-	+85	°C
Диапазон температур хранения	T_{ST}		-45	-	+85	°C
Температура пайки контактов	T_S		-	-	235	°C
Время пайки контактов	t_S		-	-	3	сек

Максимально допустимые значения:

Лазерный диод						
Мощность на выходе оптического волокна	$P_{OP \max}$		-	-	1.5	мВт
Обратное напряжение	$U_{R \max}$		-	-	2.0	В
Фотодиод обратной связи						
Напряжение смещения	$U_{REV \max}$		-	-	10	В
Допустимый ток	$I_{PD \max}$		-	-	1.5	мА

Габаритные размеры:



Схемы электрических соединений:

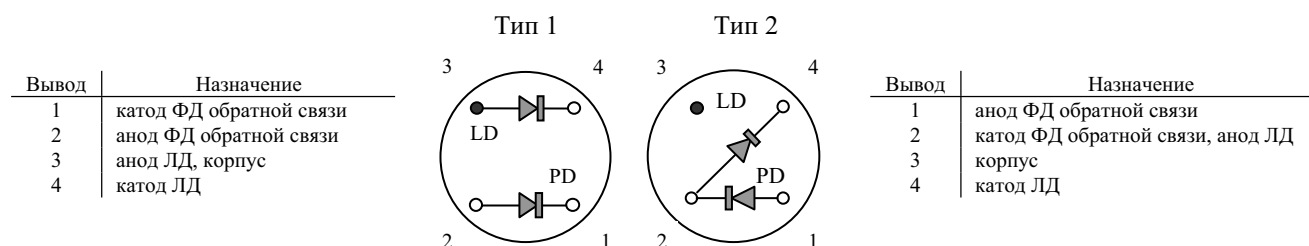
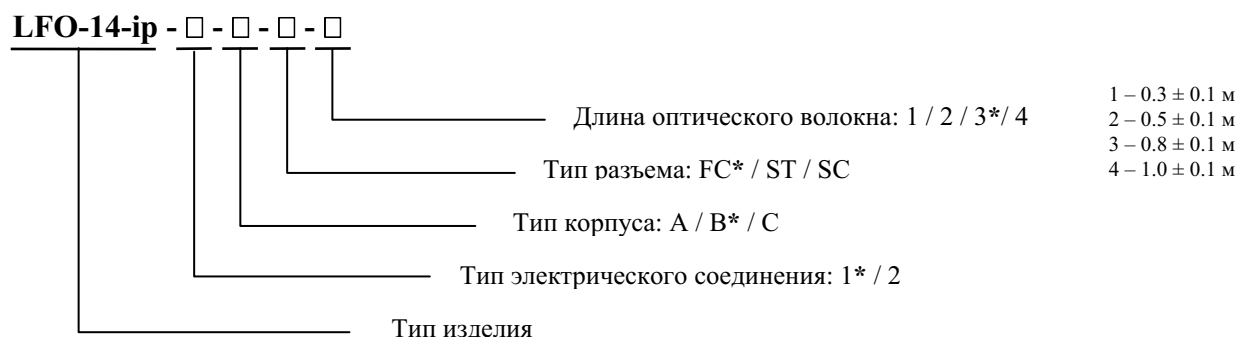


Схема условного обозначения изделия:



* - Базовое исполнение (если в заказе не указаны индивидуальные требования)